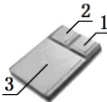


3DG8050 型 NPN 硅高频小功率晶体管

参数符号		测试条件	规范值	单位
极 限 值	P_{CM}	$T_A=25^{\circ}C$	330	mW
	I_{CM}		300	mA
	T_{jm}		175	$^{\circ}C$
	T_{stg}		-55~150	$^{\circ}C$
直 流 参 数	$V_{(BR)CBO}$	$I_{CB}=0.1mA$	≥ 30	V
	$V_{(BR)CEO}$	$I_{CE}=0.1mA$	≥ 25	V
	$V_{(BR)EBO}$	$I_{EB}=0.1mA$	≥ 6.0	V
	I_{CBO}	$V_{CB}=20V$	≤ 0.1	μA
	V_{BEsat}	$I_C=50mA$	≤ 1.2	V
	V_{CEsat}	$I_B=5mA$	≤ 0.5	V
	h_{FE}	$V_{CE}=1V$ $I_C=0.1A$	20~100	
交 流 参 数	f_T	$I_C=50mA$ $V_{CE}=10V$ $f=100MH_z$	≥ 100	MHZ
外 引 线 说 明	 SMD-0.5  A3-01B(B1)  A3-02B(B4) 1. E 发射极 2. B 基 极 3. C 集电极			
替代型号:				